(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-74064

(43)公開日 平成11年(1999)3月16日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ H05B 3/20

H05B 3/20 H01L 21/205 356

H01L 21/205

356

(19)日本国特許庁(JP)

21/3065

21/68

21/68

21/302

審査請求 未請求 請求項の数1 〇L

(全6頁)

(21)出願番号

特願平9-235275

(71)出願人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

(22) 出願日

平成9年(1997)8月29日

(72)発明者 奥田 憲男

鹿児島県国分市山下町1番1号 京セラ株

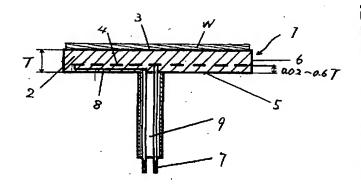
式会社鹿児島国分工場内

(54) 【発明の名称】ウエハ加熱装置

(57) 【要約】

【課題】550℃以上の高温に急速に昇温しても破損す ることがなく、繰り返し使用可能な信頼性の高い大型の ウエハ加熱装置を提供することになる。

【解決手段】円盤状をしたセラミック基体2の上面をウ エハWの保持面3とし、その内部に抵抗発熱体4を埋設 してなるウエハ加熱装置1の上記保持面3と反対側の下 面を基準面5とし、この基準面5から上記セラミック基 体2の厚みTの0.02~0.6倍の距離に前記抵抗発 熱体4を配置するとともに、この抵抗発熱体4の存在領 域Pが略円形であって、その最外周が上記セラミック基 体2の側面6から35mm以内の距離に位置するように する。



BEST AVAILABLE COPY

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】円盤状をしたセラミック基体の上面をウエハの保持面とし、その内部に抵抗発熱体を埋設してなるウエハ加熱装置において、上記保持面とは反対側の下面を基準面とし、該基準面から上記セラミック基体の厚みの0.02~0.6倍の距離に前記抵抗発熱体を配置するとともに、この抵抗発熱体の存在領域が略円形であって、その最外周が上記セラミック基体の側面から35mm以内にあることを特徴とするウエハ加熱装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、特に、半導体装置の製造工程におけるプラズマCVD、減圧CVD、光CVD、PVDなどの成膜装置や、プラズマエッチング、光エッチングなどのエッチング装置に用いられるウエハ加熱装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体装置の製造工程で使用されるプラズマCVD、減圧CVD、光CVD、PVDなどの成膜装置や、プラズマエッチング、光エッチングなど 20のエッチング装置においては、デポジッション用ガスやエッチング用ガス、あるいはクリーニング用ガスとして塩素系やフッ素系の腐食性ガスが使用されていた。

【0003】また、これらのガス雰囲気中で半導体ウエハ(以下、ウエハと略称する。)を保持しつつ加工温度に加熱するためのウエハ加熱装置として、抵抗発熱体を内蔵したステンレスヒーターが使用されていた。

【0004】しかしながら、ステンレスヒーターは、上 記腐食性ガスに曝されると腐食摩耗し、パーティクルが 発生するといった問題点があった。

【0005】一方、腐食性ガスに対して比較的優れた耐蝕性を有するグラファイトによりウエハ加熱装置を形成し、このウエハ加熱装置をチャンパー外に設置された赤外線ランプによって間接的に加熱することも行われているが、直接加熱のものに比べて熱効率が悪いといった問題点があった。しかも、成膜装置においては膜がチャンパーの壁面に堆積し、この膜での熱吸収が発生することから、ウエハ加熱装置を加熱できなくなるといった不都合もあった。

【0006】そこで、このような問題点を解消するウエ 40 ハ加熱装置として、円盤状をした緻密質のセラミック基体の内部に、高融点金属からなる抵抗発熱体を埋設したセラミックヒーターが提案されている(特開平4-10 1381号公報参照)。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、近年、半導体装置の集積度の向上に伴ってウエハの外径が当初6インチであったものが8インチ、12インチと大きくなっており、ウエハの大型化に伴ってウエハ加熱装置も大型のものが要求されるようになっていた。

【0008】また、ウエハの加熱温度も年々上昇し、従来400℃程度であったものが、550℃、さらには850℃以上の高温で処理されるようになり、さらには生産効率を高めるために急速昇温が可能なウエハ加熱装置が求められるようになっていた。

【0009】しかしながら、8インチ以上の大きさを有するセラミックヒーターを550℃以上の温度に発熱させると、昇温時にセラミックヒーター内に発生する熱応力が大きくなり、割れ易いという課題があった。

10 [0010]

【発明の目的】本発明の目的は、550℃以上の高温に 急速に昇温しても破損することがなく、繰り返し使用可 能な信頼性の高い大型のウエハ加熱装置を提供すること になる。

[0011]

【課題を解決するための手段】本件発明者は、抵抗発熱体を埋設したセラミックヒーターからなるウエハ加熱装置における破損の原因について鋭意研究を重ねたところ、セラミック基体内における抵抗発熱体の存在領域と抵抗発熱体の埋設位置が関係していることを突き止めた。

【0012】即ち、本発明は、円盤状をしたセラミック基体の上面をウエハの保持面とし、その内部に抵抗発熱体を埋設してなるウエハ加熱装置において、上記保持面とは反対側の下面を基準面とし、該基準面から上記セラミック基体の厚みの0.02~0.6倍の距離に前記抵抗発熱体を配置するとともに、この抵抗発熱体の存在領域が略円形であって、その最外間が上記セラミック基体の側面から35mm以内の距離に位置するようにしたことを特徴とするものである。

【0013】なお、本発明のウエハ加熱装置は、抵抗発熱体がどのようなヒーターパターンを有するものであっても構わないが、略円盤状をしたウエハを均一に加熱するために、抵抗発熱体が存在する領域の形状を略円形とすることが望ましい。また、抵抗発熱体の最外周からセラミック基体の側面までの距離とは、ヒーターパターンのうち最も外側に位置する抵抗発熱体からセラミック基体の側面までの距離のことである。

[0014]

) 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 説明する。

【0015】図1はサセプタと呼ばれる本発明のウエハ加熱装置1を示す斜視図、図2は図1のX-X線断面図、図3は抵抗発熱体4のヒーターパターンを示す模式図である。

【0016】このウエハ加熱装置1は、円盤状をした緻密質のセラミック基体2からなり、上面をウエハWの保持面3とするとともに、その内部に抵抗発熱体4を埋設してある。セラミック基体2の厚みTは通常5~25m m程度で、上記保持面3と反対側の下面を基準面5と

し、この基準面5から上記セラミック基体2の厚みTの 0.02~0.6倍の距離に前記抵抗発熱体4を配置し てある。

【0017】この抵抗発熱体4のヒーターパターンは、 図3に示すように中央から外周へ向かう渦巻き状とし、 抵抗発熱体4の存在領域Pが略円形となるように構成し てあり、略円盤状をしたウエハを均一に加熱することが できる。

【0018】なお、ヒーターパターンの中央に位置する 抵抗発熱体4の一方端は、基準面5の中央付近にロウ付 10 け固定した外部端子7と接続するとともに、ヒーターパ ターンの周縁に位置する抵抗発熱体4の他方端は、上記 抵抗発熱体4より下層に設けた導体8を介して基準面5 の中央付近にロウ付け固定したもう一方の外部端子7と 接続してあり、両外部端子7に電圧を印加することで抵 抗発熱体4を発熱させ、保持面4に載置したウエハWを 加熱するようになっている。

【0019】また、9はウエハ加熱装置1をチャンバー 内に設置するとともに、上記外部端子7がチャンバー内 の腐食性ガスに曝されるのを防ぐための円筒状支持体で 20 ある。

【0020】ところで、抵抗発熱体4の埋設位置を、セ ラミック基体2の基準面5からセラミック基体2の厚み Tの0.02~0.6倍の距離とするのは、セラミック 基体2の厚みTの0.6倍より上では、抵抗発熱体4が ウエハWの保持面3に近づきすぎるため、抵抗発熱体4 が位置する保持面3上と、抵抗発熱体4のない保持面3 上との温度差が大きくなりすぎるとともに、抵抗発熱体 4の持つ抵抗バラツキに伴う温度バラツキによって、保 持面3の温度バラツキが±1%を越え、均熱化が阻害さ 30 れるからであり、逆に、セラミック基体2の厚みTの 0.02倍より下では、急速昇温時に抵抗発熱体4とセ ラミック基体2の保持面3との間に大きな熱応力が加わ り、図4(a)に示すような基準面5を起点とするセラ ミック基体2の割れ易くなるからである。

【0021】また、急速昇温を実現するためには、セラ ミック基体2の側面6から抵抗発熱体4の最外周までの 距離Lを35mm以内とすることが重要である。

【0022】これは、セラミック基体2の側面6から抵 抗発熱体4の最外周までの距離しが35mmより大きく 40 なると、セラミック基体2の側面6と抵抗発熱体4との 間に大きな熱応力が加わり、図4(b)に示すような側 面6を起点とするセラミック基体2の割れが発生するか らである。しかも、セラミック基体2の外径がウエハW と同等、あるいはウエハWより若干小さい場合、抵抗発 熱体4の存在領域PがウエハWより小さくなりすぎるた め、ウエハWの周縁部における均熱性が低下し、この周 縁部よりチップを取り出すことができないといった不都 合があるからである。ただし、セラミック基体2の側面 6から抵抗発熱体4の最外周までの距離Lを0.5mm 50 してなるセラミック基体2を形成したあと、セラミック

より小さくすることは製造上難しい。

【0023】従って、セラミック基体2の側面6から抵 抗発熱体4の最外周までの距離しは0.5~35mmと することが良い。

【0024】なお、本実施形態では、抵抗発熱体4のヒ ーターパターンとして、渦巻き状をした例を示したが、 本発明のヒーターパターンはこの渦巻き状をしたものだ けに限定されるものではなく、例えば、図5 (a)

(b) に示すようなさまざまなヒーターパターンを採用 することができ、抵抗発熱体4の存在領域Pの形状が略 円形をしたものであれば良い。

【0025】一方、ウエハ加熱装置1を構成するセラミ ック基体2の材質としては、耐摩耗性、耐熱性に優れる アルミナ、窒化珪素、サイアロン、窒化アルミニウムを 用いることができ、この中でも特に窒化アルミニウムは 50W/mk以上、さらには100W/mk以上の高い 熱伝導率を有するとともに、フッ素系や塩素系等の腐食 性ガスに対する耐蝕性や耐プレズマ性にも優れることか ら、セラミック基体2の材質として好適である。

【0026】また、セラミック基体2に埋設する抵抗発 熱体4は、線材や薄いシート膜状の形態をしたものを用 いることができるが、昇温時間をより短くできる点で薄 いシート膜の方が好ましい。さらに、抵抗発熱体4を構 成する材質としては、タングステン、モリブデン、レニ ュウム、白金等の高融点金属やこれらの合金、あるいは 周期律表第4 a 族、第5 a 族、第6 a 族の炭化物や窒化 物を用いることができ、セラミック基体2との熱膨張差 の小さいものを適宜選択して使用すれば良い。

【0027】このようなウエハ加熱装置1を製造する方 法としては、抵抗発熱体4が薄いシート膜状である時に は、まず、セラミック基体2をなすセラミック粉末に、 バインダーや溶媒等を加えて泥漿を作製し、ドクターブ レード法などのテープ成形法により複数枚のグリーンシ ートを形成したあと、予め数枚のグリーンシートを積層 し、その上面に抵抗発熱体4をなすペーストをスクリー ン印刷機にて抵抗発熱体4の存在領域Pが略円形をした 図3に示す中央から外周へ向かう渦巻き状のヒーターパ ターンに形成する。

【0028】そして、残りのグリーンシートを積層して グリーンシート積層体を製作したあと、円盤状に切削す る。なお、この積層工程において、焼成後のグリーンシ ートの収縮を考慮して抵抗発熱体4の埋設位置が基準面 5からセラミック基体2の厚みTの0.02~0.6倍 の距離に位置するとともに、セラミック基体2の側面6 から抵抗発熱体4の最外周までの距離Lが35mm以下 となるように設計することが必要である。

【0029】しかるのち、セラミック粉末を焼結させる ことができる温度にて上記グリーンシート積層体を焼成 することにより、薄いシート膜状の抵抗発熱体4を埋設

10

基体2の上面に研摩加工を施してウエハWの保持面3を 形成するとともに、下面に研摩加工を施して基準面5を 形成し、この基準面5の中央付近に上記抵抗発熱体4を 貫通する2つの下穴をそれぞれ穿設したあと、この下穴 に外部端子7をロウ付けすることにより、抵抗発熱体4 と外部端子7を電気的に接続すれば良い。

【0030】また、抵抗発熱体4が線材である時には、 まず、セラミック基体2をなすセラミック粉末に、バイ ンダーや溶媒等を加えて混練乾燥したあと造粒して顆粒 を製作し、この顆粒を円盤状をした金型内に充填して、 上パンチにより溝を形成したあと、この溝に抵抗発熱体 4をなす線材を抵抗発熱体4の存在領域Pが略円形をし た図3に示す中央から外周へ向かう渦巻き状のヒーター パターンに設置し、さらに顆粒を充填してホットプレス 成形することにより、線材の抵抗発熱体 4 を埋設したセ ラミック基体2を形成する。

【0031】しかるのち、セラミック基体2の上面に研 摩加工を施してウエハWの保持面3を形成するととも に、下面に研摩加工を施して基準面5を形成し、この基 準面5の中央付近に上記抵抗発熱体4を貫通する2つの 20 下穴をそれぞれ穿設したあと、この下穴に外部端子7を ロウ付けすることにより、抵抗発熱体4と外部端子7を 電気的に接続すれば良い。

【0032】なお、図1ではセラミック基体2の内部に 抵抗発熱体4のみを備えたウエハ加熱装置1について示 したが、本発明は、図6に示すようなウエハWの保持面 3と抵抗発熱体4との間に静電吸着用やプラズマ発生用 としての膜状電極10を埋設したものであっても良いこ とは言うまでもない。

【0033】 (実施例1) ここで、抵抗発熱体4の埋設 30 位置を異ならせた図1のウエハ加熱装置1を用意し、保 持面3の温度バラツキと熱サイクルを加えた時のセラミ ック基体2の割れ発生率について実験を行った。

【0034】本実験では、外径300mm、厚みT17 mmの円盤状をしたセラミック基体2を、純度99.9 %の窒化アルミニウム質焼結体により形成し、その内部 にシート膜状のタングステンからなる抵抗発熱体4を埋 設したものを使用した。また、抵抗発熱体4のヒーター パターンは存在領域Pが略円形をした図3に示す渦巻き 状とし、セラミック基体2の側面6から抵抗発熱体4の 40 最外周までの距離しを10mmとした。

【0035】そして、抵抗発熱体4の埋設位置を異なら せたウエハ加熱装置1に電圧を印加して飽和温度が85 0℃となるように発熱させ、保持面3上の温度分布を商 品名:サーモビュアーで測定し、最大温度と最小温度の 差が平均温度に対して何%であるかを測定した。

【0036】次に、抵抗発熱体4の埋設位置を異ならせ たウエハ加熱装置1を各30個づつ用意し、50℃/分 の速度で850℃まで昇温したあと、この飽和温度で2 時間保持し、そのあと150℃まで冷却する熱サイクル 50 試験を500サイクル行ったあとの割れ発生率を測定し

【0037】それぞれの結果は表1に示す通りである。 [0038]

【表1】

No	基準面から抵抗 発熱体までの距離T	保持面の温度 パラツキ(%)	せうミック 基体の 割れ発生率(%)
% 1	0. 9 T	3. 3	0
※ 2	0.8T	2. 0	0
3	0. 6Т	1. 0	0
4	0. 4 T	0. 7	0
5	0. 2 T	0. 6	0
6	0. 1 T	0.5	0
7	0. 05T	0.3	0
8	0. 02T	0. 4	0
※ 9	0. 015T	0.4	3. 3
※10	0. 010T	0.3	6. 6
※11	0. 005T	0.3	13.3

※は本発明範囲外である。

【0039】この結果、抵抗発熱体4の埋設位置がセラ ミック基体2の基準面5からセラミック基体2の厚みT の0.6倍より小さい位置では、保持面3における温度 バラツキを1.0%以下に抑えることができる。

【0040】ただし、抵抗発熱体4の埋設位置がセラミ ック基体2の基準面5からセラミック基体2の厚みTの 0.02倍より小さくなりすぎると、セラミック基体2 の割れが発生した。

【0041】この結果、抵抗発熱体4の埋設位置は、セ ラミック基体2の基準面5からセラミック基体2の厚み Tの0.02~0.6倍の距離に配置すれば良いことが 判る。

【0042】 (実施例2) 次に、抵抗発熱体4の埋設位 置を、セラミック基体2の基準面5からセラミック基体 2の厚みTの0. 1倍の距離に設定し、セラミック基体 2の側面6から抵抗発熱体4の最外周までの距離しをそ れぞれ変化させたウエハ加熱装置1を各30個づつ用意 し、実施例1と同様に50℃/分の速度で850℃まで 昇温したあと、この飽和温度で2時間保持し、そのあと 150℃まで冷却する熱サイクル試験を500サイクル 行ったあとの割れ発生率を測定した。

【0043】それぞれの結果は表2に示す通りである。 [0044]

【表2】

No	tiミック 基体の側面から 抵抗発熱体までの距離T	せうミック 基体の 割れ発生率(%)
1	1 0 mm	0
2	2 0 mm	0
3	3 0 mm	0
4	3 5 mm	0
※ 5	4 0 mm	3. 3
※ 6	4 5 mm	10.0
※ 7	5 0 mm	13.3

7

※は本発明範囲外である。

【0045】この結果、セラミック基体2の側面6から抵抗発熱体4の最外周までの距離Lを35mm以内とすればセラミック基体2に割れを生じることがなかった。 【0046】

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、円盤状をしたセラミック基体の上面をウエハの保持面とし、そ 20の内部に抵抗発熱体を埋設してなるウエハ加熱装置において、上記保持面とは反対側の下面を基準面とし、該基準面から上記セラミック基体の厚みの0.02~0.6倍の距離に前記抵抗発熱体を配置するとともに、上記抵抗発熱体の存在領域が略円形であって、その最外周が上記セラミック基体の側面から35mm以内の距離に位置

するようにしたことから、急速昇温を繰り返したとして も熱応力により破損することがなく、また、ウエハWの 保持面における均熱性を高めることができる。

【0047】その為、本発明のウエハ加熱装置を用いれば、成膜速度やエッチング速度を高め、半導体装置の生産効率を向上させることができるとともに、常に品質の高い半導体装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】サセプタと呼ばれる本発明のウエハ加熱装置を10 示す斜視図である。

【図2】図1のX-X線断面図である。

【図3】抵抗発熱体のヒーターパターンを示す模式図である。

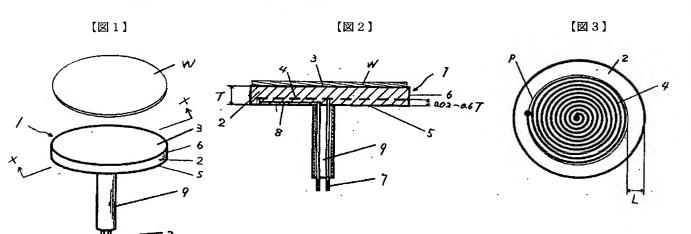
【図4】(a)(b)はセラミック基体の割れ発生状況を示す模式図である。

【図5】(a)(b)は抵抗発熱体の他のヒーターパターンを示す模式図である。

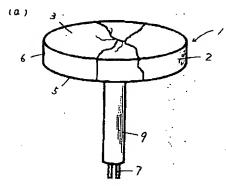
【図6】本発明の他のウエハ加熱装置を示す縦断面図である。

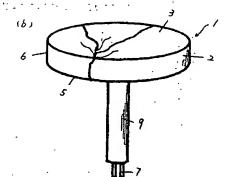
) 【符号の説明】

1・・・ウエハ加熱装置、 2・・・セラミック基体、
3・・・保持面、4・・・抵抗発熱体、 5・・・基準面、 6・・・側面、7・・・外部端子、8・・・導体、9・・・円筒状支持体、10・・・膜状電極、W・・・半導体ウエハ

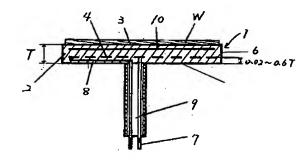


[図4]

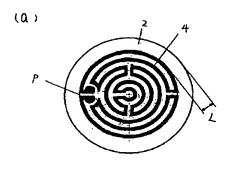


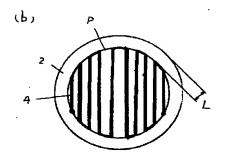


【図6】



[図5]





PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-074064

(43)Date of publication of application: 16.03.1999

(51)Int.CI.

H05B 3/20 H01L 21/205 H01L 21/3065 H01L 21/68

(21)Application number: 09-235275

(22)Date of filing:

(71)Applicant:

KYOCERA CORP

29.08.1997

(72)Inventor:

OKUDA NORIO

(54) WAFER HEATING DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a large-sized wafer heating device, which is not broken even at the time of being heated rapidly up to a high temperature over 550° C and can be used repeatedly and also has high

SOLUTION: In this wafer heating device, which is composed of a disc-shaped ceramic substrate 2, the upper surface of which is a retaining surface 3 of a wafer W, and a resistance exothermic body 4 buried in its inside, the resistance exothermic body 4 is arranged at the distance of 0.02-0.6 time of the thickness T of the ceramic substrate 2 from a standard face 5, which is an under surface on the opposite side of the retaining surface 3. Also, the existing area (P) of the resistance exothermic body 4 is to form a roughly round shape, and the extreme 22 circumference thereof is located within the distance of 35 mm from the side 6 of the ceramic substrate 2.

